

省エネルギー社会の実現に資する 次世代半導体研究開発

第2回公開シンポジウム

—青からパワーへ 離陸する革新的省エネ技術—

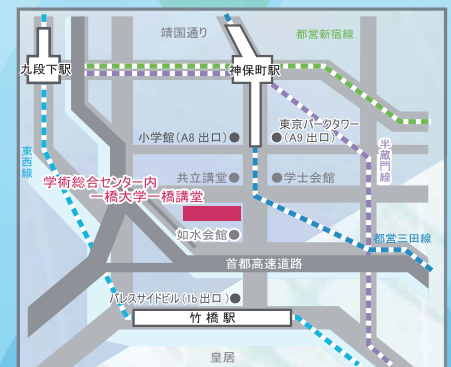
平成28年度に始まった「省エネルギー社会の実現に資する次世代半導体研究開発」では、日本発の窒化ガリウム（GaN）材料を用いてデバイスの省エネルギー化を目指す研究開発を進めてきました。

GaNを使った高効率なパワーデバイスは、日常生活やインフラの省エネ化を、GaNを使った高効率な光源は、安心・安全な生活・環境を世界に広げます。GaNには、エネルギーや空間の未来を変えていく、大きな可能性があります。

今年には本プロジェクトの中間年。

これまで得られた、世界初などの革新的な研究成果をご紹介すると共に、今後の研究開発の方向性、成果をどのように産業へ応用し、社会実装へ結びつけていくか、議論・討論を行います。

会場：学術総合センター一橋講堂
(東京都千代田区一ツ橋2丁目1-2)



アクセス 神保町駅(A8・A9出口) 徒歩4分
竹橋駅(1b出口) 徒歩4分

平成30年

5/16

水

14:00-17:00

事前申込制・参加無料

申込み
方法

下記ウェブサイトにてお申し込み下さい(先着順・定員500名)

<http://www.aip.nagoya-u.ac.jp/event/detail/0004279.html>



プログラム

- (1) 開会挨拶 文部科学省
- (2) 来賓挨拶
- (3) 事業概要
- (4) 成果報告

- ・中核拠点(名古屋大学)
- ・評価基盤領域(物質・材料研究機構)
- ・パワーデバイス・システム領域(名古屋大学)
- ・レーザーデバイス・システム領域(名城大学)

- (5) パネルディスカッション「GaNが作る未来社会」
谷口研二プログラムディレクター(大阪大学)
天野浩教授(名古屋大学)
他 GaN関連の産業界から

- (6) 閉会挨拶 文部科学省

お問い合わせ

名古屋大学 シンポジウム担当

TEL: 052-789-4685 FAX: 052-747-6796 E-MAIL: gan-oubo@aip.nagoya-u.ac.jp



中核拠点研究代表者 天野浩教授
(2014年ノーベル物理学賞受賞)